

MIEDC-103-A206

全球 3DIC 技術發展 趨勢-TSV 蝕刻製程

作者：陳慧娟

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇三年七月

目錄

■ 摘要	1
■ 前言	2
■ 矽穿孔蝕刻製程技術.....	2
■ 結論.....	8



全球 3D IC 技術發展趨勢-TSV 蝕刻製程

金屬中心 MII 產業分析師 陳慧娟

摘要：

3D IC 的 TSV 製程可分成蝕刻以及填孔兩部分，良好的 TSV 製程技術可以避免漏電流以及金屬擴散汙染等問題。TSV 蝕刻可以經由雷射鑽孔、濕式蝕刻、電漿蝕刻以及極低溫蝕刻來達成，而判定蝕刻的好壞可由 TSV 的輪廓來決定，在本報告中將深入探討各種蝕刻方法影響 TSV 輪廓的原因，並分析此四種方法的優劣，以了解不同的蝕刻製程方法適合的產品與市場，最後並剖析未來 TSV 蝕刻的未來趨勢。

《全球 3DIC 技術發展趨勢-TSV 蝕刻製程》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>